



超高纯锗

以高纯锗晶体为探测介质的高纯锗探测器具有优越的能量分辨率、较宽的能量测量范围、较高的探测效率等优点，在暗物质探测、核电、材料科学、微量元素分析、安检等领域具有广阔的应用前景。光智科技致力于不断创新和开发高纯锗晶体及探测器生产技术，为客户提供最优解决方案。

产品特点

净杂质浓度	$<2 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$
-------	-------------------------------------

传输特性-霍尔迁移率 μH	
p型 μH	$\geq 10\,000 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ (中心测量)
n型 μH	$\geq 10\,000 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ (中心测量)

深能级 (深能级瞬态光谱检测 (DLTS) 测量)	
p型	$\text{Cu}_{\text{tot}} \leq 4.5 \times 10^9 \text{ cm}^{-3}$
n型	深能级杂质中心浓度 $< 5 \times 10^8 \text{ cm}^{-3}$

晶体缺陷	p型	n型
位错密度 (EPD, cm^{-2})	$\leq 10\,000$	$\leq 5\,000$
系属结构 (unit length = slice radius)	≤ 4	≤ 3
镶嵌结构 (unit surface = 10 mm^2)	≤ 6	≤ 3
蝶形坑缺陷密度 (cm^{-2})	≤ 500	≤ 500